# Задача 3.3.4 Эффект Холла в полупроводниках

Лось Денис (группа 611) 19 октября 2017

**Цель работы:** измерение подвижности и концентрации носителей заряда в полупроводниках.

**В работе используются:** электромагнит с источником питания, цифровой вольтметр, батарейка 1.5 В, реостат, миллиамперметр, образцы легированного германия, измеритель магнитной индукции.

## Экспериментальная установка

Электрическая схема установки для измерения ЭДС Холла представлена на рис.1

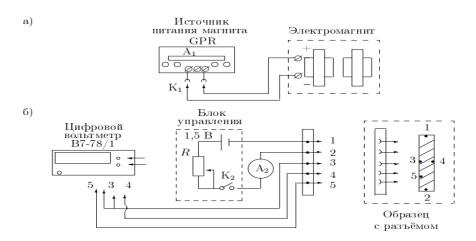


Рис. 1: Схема установки для исследования эффекта Холла в полупроводниках

В зазоре электромагнита создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью регуляторов источника питания электромагнита. Ток питания электромагнита измеряется амперметром источника питания  $A_1$ . Разъём  $K_1$  позволяет менять направление тока в обмотках электромагнита.

Образец из легированного германия, смонтированный в специальном держателе, подключается к батарее. При замыкании ключа  $K_2$  вдоль длинной стороны образца

течёт ток, величина которого регулируется реостатом R и измеряется миллиамперметром  $A_2$ . В образце с током, помещённом в зазор электромагнита, между контактами 3 и 4 возникает разность потенциалом  $U_{34}$ , которая измеряется с помощью цифрового вольтметра.

Контакты 3 и 4 вследствие неточности подпайки не всегда лежат на одной эквипотенциали, и тогда напряжение между ними связано не только с эффектом Холла, но и с омическим падением напряжения, вызванным протеканием основного тока через образец. Измеряемая разность потенциалов при одном направлении магнитного поля равна сумме ЭДС Холла и омического падения напряжения, а при другом их разности. В этом случае ЭДС Холла  $\mathbb{E}_x$  может быть определено как половина алгебраической разности показаний вольтметра, полученных для двух противоположных направлений магнитного поля в зазоре.

Однако можно исключить влияние омического падения напряжения иначе, если при каждом токе через образец измерять напряжение между точками 3 и 4 в отсутствие магнитного поля. Тогда величина ЭДС Холла  $\mathcal{E}_X = U_{34} + U_0$ . При таком способе измерения нет необходимости проводить повторные измерения с противоложным направлением магнитного поля.

Измерив ток I и напряжение  $U_{35}$  между контактами 3 и 5 в отсутствие магнитного поля, можно, зная параметры образца, рассчитать проводимость материала образца:

$$\sigma = \frac{L_{35}}{a \cdot l} \frac{I}{U_{35}},$$

где  $L_{35}$  — расстояние между контактами 3 и 5, a — толщина образца, l — его ширина.

# Ход работы

#### Параметры установки

В данной экспериментальной установке:

$$a=2.2\,\mathrm{mm}$$
  $L_{35}=3.0\,\mathrm{mm}$   $l=2.5\,\mathrm{mm}$ 

#### Градуировка электромагнита

Проведём измерения магнитной индукции B в зависимости от значения тока через электромагнит  $I_m$  и построим график зависимости  $B = f(I_m)$ .

В, мТл	887	840	784	712	629	537	441	340	253	143
I, A	1.05	0.95	0.85	0.75	0.65	0.54	0.44	0.34	0.25	0.15

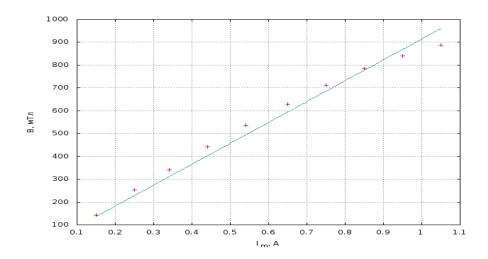


Рис. 2: График зависимости  $B = f(I_m)$ 

Определив коэффициент наклона графика, получим, что:

$$B = 915 \cdot I \quad (\sigma_B = 2\%)$$
,

где I измеряется в амперах, а значение B получается в миллитеслах.

#### Измерение ЭДС Холла

1. Проведём измерения ЭДС Холла при различных значениях тока через образец. Для этого вставим образец в зазор выключенного электромагнита и будем определять напряжение  $U_0$  между холловскими контактами 3 и 4 для каждого значения тока через образец. Включив электромагнит, снимем зависимость напряжения  $U_{34}$  от тока  $I_m$  через обмотки магнита для каждого фиксированного тока через образец.

$\mathscr{E}_x$ , MK	B   -4	14	-41	-38	-35	-31	-28	-22	-16
I, A	1.1	19	1.00	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.35

Таблица 1: Таблица измерения  $U_{34}=f(I_m)$  при  $I=0.25~\mathrm{mA}$  и  $U_0=-10~\mathrm{mkB}$ 

$\mathscr{E}_x$ , мкВ	-71	-65	-59	-50	-41	-35	-23
I, A	1.25	1.05	0.9	0.75	0.6	0.5	0.35

Таблица 2: Таблица измерения  $U_{34}=f(I_m)$  при I=0.4 мА и  $U_0=-15$  мкВ

$\mathscr{E}_x$ , мкВ	-89	-82	-74	-63	-52	-43	-29
I, A	1.25	1.05	0.9	0.75	0.6	0.5	0.35

Таблица 3: Таблица измерения  $U_{34}=f(I_m)$  при I=0.5 мА и  $U_0=-19$  мкВ

$\mathscr{E}_x$ , мкВ	-106	-97	-87	-75	-61	-51	-35
I, A	1.25	1.05	0.9	0.75	0.6	0.5	0.35

Таблица 4: Таблица измерения  $U_{34}=f(I_m)$  при I=0.6 мА и  $U_0=-22$  мкВ

$\mathscr{E}_x$ , мкВ	-124	-113	-103	-88	-71	-59	-42
I, A	1.25	1.05	0.9	0.75	0.6	0.5	0.35

Таблица 5: Таблица измерения  $U_{34}=f(I_m)$  при I=0.7 мА и  $U_0=-26$  мкВ

	$\mathscr{E}_x$ , мкВ	-142	-129	-117	-101	-82	-69	-48
ľ	I, A	1.25	1.05	0.9	0.75	0.6	0.5	0.35

Таблица 6: Таблица измерения  $U_{34}=f(I_m)$  при I=0.8 мА и  $U_0=-30$  мкВ

$\mathscr{E}_x$ , мк $\mathrm{B}$	-163	-146	-132	-114	-92	-77	-53
I, A	1.25	1.05	0.9	0.75	0.6	0.5	0.35

Таблица 7: Таблица измерения  $U_{34}=f(I_m)$  при I=0.9 мА и  $U_0=-33$  мкВ

$\mathscr{E}_x$ , мкВ	-178	-163	-147	-127	-103	-87	-59
I, A	1.25	1.05	0.9	0.75	0.6	0.5	0.35

Таблица 8: Таблица измерения  $U_{34}=f(I_m)$  при I=1.0 мА и  $U_0=-37$  мкВ

Проведём измерения  $U_{34}=f(I_m)$  при другом направлении магнитного поля (повернув образец на  $180^\circ$  вокруг горизонтальной оси, проходящей вдоль ручки держателя).

$\mathscr{E}_x$ , мк $\mathrm{B}$	-178	-163	-147	-126	-104	-86	-61
I, A	1.25	1.05	0.9	0.75	0.6	0.5	0.35

Таблица 9: Таблица измерения  $U_{34}=f(I_m)$  при I=1.0 мА и  $U_0=-44$  мкВ

2. Построим семейство характеристик  $\mathscr{E}_x = f(B)$  при разных значениях тока I через образец. Определим угловые коэффициенты  $k(I) = \Delta \mathscr{E}_x/\Delta B$  полученных прямых.

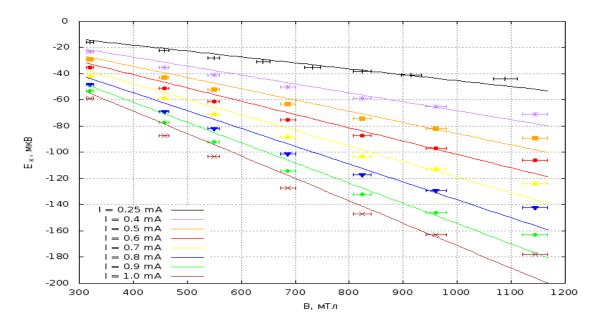


Рис. 3: График зависимости  $\mathscr{E}_x = f(B)$  при разных значениях тока I

k(I), мВ / Тл	<i>I</i> , мА	$\Delta_k$
-0.0452	0.25	0.0013
-0.068	0.4	0.002
-0.086	0.5	0.003
-0.102	0.6	0.003
-0.119	0.7	0.003
-0.136	0.8	0.004
-0.154	0.9	0.004
-0.171	1.0	0.005

3. Построим график k=f(I) и найдём коэффициент его наклона. Определим величину постоянной Холла  $R_x$  как

$$R_x = -\frac{\Delta k(I)}{\Delta I} \cdot a$$

Далее рассчитаем концетрацию n носителей тока в образце по формуле:

$$n = \frac{1}{e \cdot R_x}$$

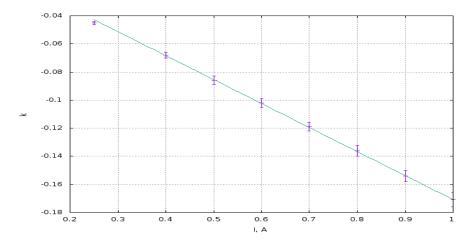


Рис. 4: График зависимости k = f(I)

С помощью метода наименьших квадратов получим, что

$$\frac{\Delta k(I)}{\Delta I} = -(170.8 \pm 0.5) \cdot 10^{-3} \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{T}_{\mathrm{J}} \cdot \mathrm{A}}$$

Следовательно,

$$R_x = (357.6 \pm 1.2) \cdot 10^{-6} \frac{\text{M}^3}{\text{K}_{\text{TI}}}$$

Тогда концентрация носителей тока в образце

$$n = (1.748 \pm 0.006) \cdot 10^{22} \, \frac{1}{\text{m}^3}$$

## Определение характера проводимости

В данном случае проводимость дырочная. Иллюстрации приведены в приложении к отчёту.

#### Определение удельной проводимости

При токе через образец I=1 мА измерим падение напряжения  $U_{35}$ . Получим, что  $U_{35}=1.765$  мВ. Проводимость материала

$$\sigma = (309.0 \pm 0.2) \frac{1}{\text{OM} \cdot \text{M}}.$$

Следовательно, подвижность носителей тока

$$b = \frac{\sigma}{en} = (1104 \pm 3) \frac{\text{cm}^2}{\text{B} \cdot \text{c}}$$